

## LYNM6660、LYNM6661 小功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管

### 1 特性

开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小安全工作区宽，温度稳定性好；  
替代国外型号：2N6660、2N6661。

### 2 质量等级及执行标准

G、G+：Q/RBJ1004QZ，QJZ840611。

### 3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

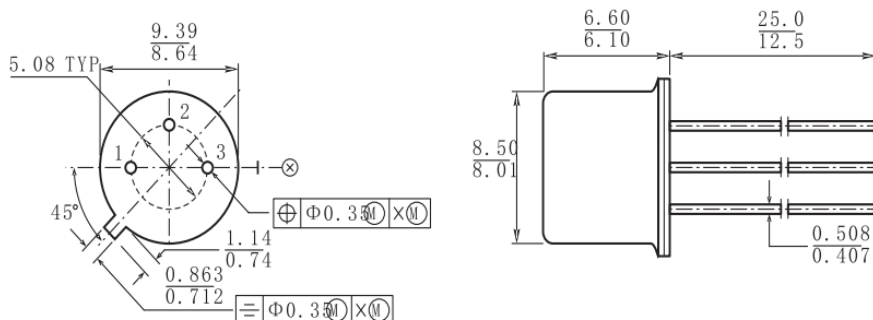
参数 名称	封装 型号	A3-02B	UA	A3-02B	UA	单位
		LYNM6660	LYNM6660UA	LYNM6661	LYNM6661UA	
额定功率 $P_D$ ( $T_c=25^{\circ}\text{C}$ )		725	725	725	725	mW
漏极电流 $I_{DM}$		0.99	0.99	0.86	0.86	A
漏源击穿电压 $BV_{DSS}$		60	60	90	90	V

### 4 主要电特性

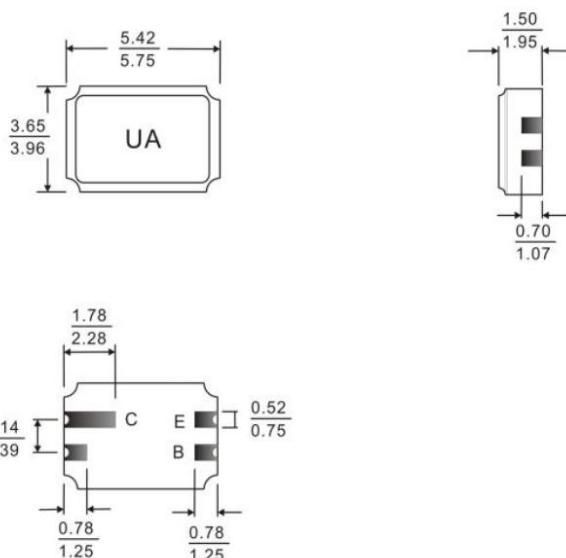
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

参数名称	符号	测试条件		规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{\text{DS}}$	LYNM6660	$V_{\text{GS}}=10\text{V}, I_{\text{D}}=1\text{A}$	—	2.0	3.0	$\Omega$
		LYNM6661			3.0	4.0	
漏源击穿电压	$BV_{\text{DSS}}$	LYNM6660	$V_{\text{GS}}=0\text{V}, I_{\text{D}}=10\text{ }\mu\text{A}$	60	90	—	V
		LYNM6661		90	110		
开启电压	$V_{\text{GS}}$	$V_{\text{DS}}=V_{\text{GS}}, I_{\text{D}}=1\text{mA}$		0.8	—	2.5	V
零栅压漏极电流	$I_{\text{DSS}}$	$V_{\text{DS}}=0.8BV_{\text{DSS}}, V_{\text{GS}}=0\text{V}$		—	—	1	$\mu\text{A}$
正向栅极漏电流	$I_{\text{GSSF}}$	$V_{\text{GS}}=15\text{V}$		—	—	100	nA
反向栅极漏电流	$I_{\text{GSSR}}$	$V_{\text{GS}}=-15\text{V}$		—	—	-100	nA
电容	$C_{\text{ISS}}$	$V_{\text{DS}}=25\text{V}, V_{\text{GS}}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		—	30	50	pF

## 5 外形尺寸



A3-02B 外形尺寸



UA 外形尺寸

## 6、使用和维护

### 6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

### 6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。